МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника Лабораторный практикум No3

Работу выполнил: студент группы ИУ7-31Б Мицевич Максим Работу проверил: Оглоблин Д. И.

Цель работы - проведение экспериментальных исследований (натурных и модельных в программах схемотехнического анализа MathCad14и Multisim) полупроводникового диода с целью получения исходных данных для расчёта параметров модели полупроводникового диода и внесение модели в базу данных программ схемотехнического анализа.

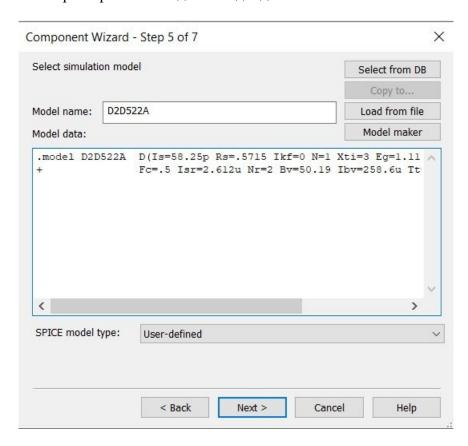
Диод моего варианта:

```
* Variant 14
.model D2D522A D(Is=58.25p Rs=.5715 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=2.658p M=.154 Vj=.75
+ Fc=.5 Isr=2.612u Nr=2 Bv=50.19 Ibv=258.6u Tt=2.232n)
```

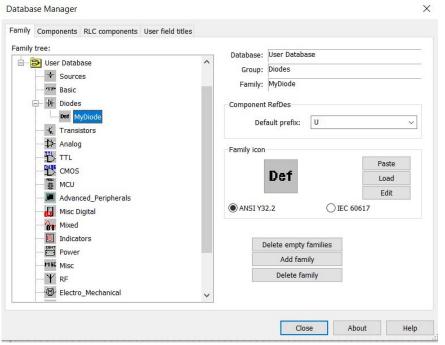
Эксперимент №1

Создадим новое семейство, где будут размещаться добавленные компоненты. Далее открываем мастер создания компонента.

Заполняя окна, которые предлагает мастер создания дойдем до окна с характеристиками диода, куда внесем характеристики выданного диода:

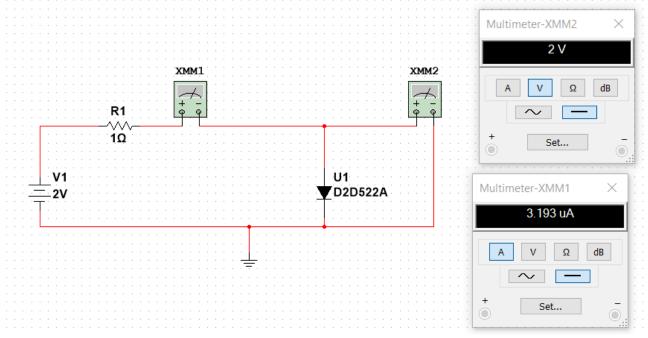


После заполнения всех пунктов мастера создания можем найти диод в пользовательской базе данных:

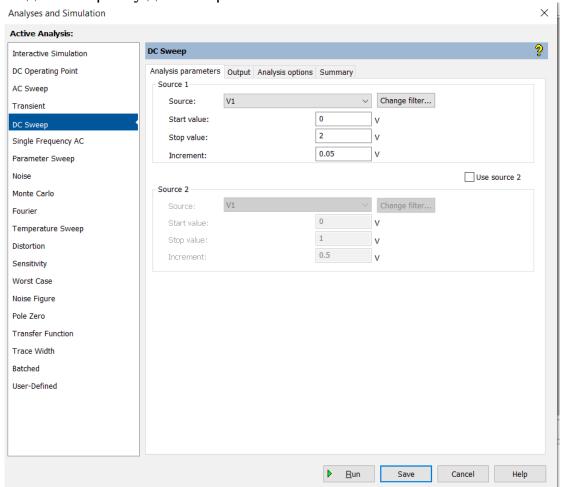


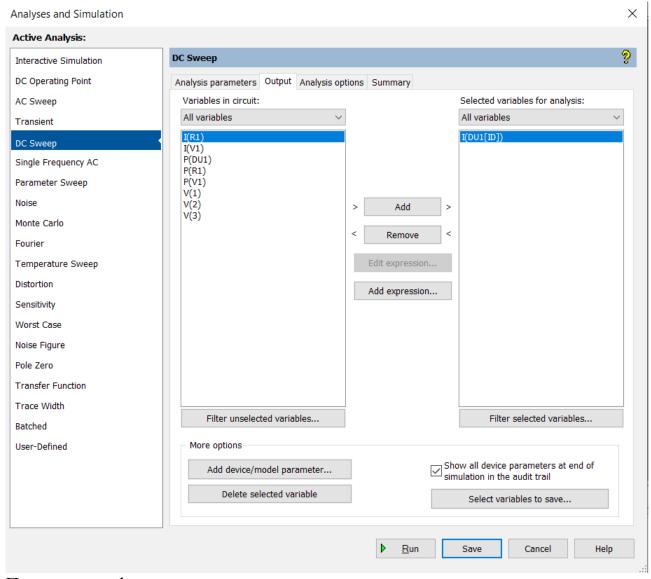
Эксперимент №2

Строим стенд моделирования и производим замеры тока и напряжения через мультиметры.

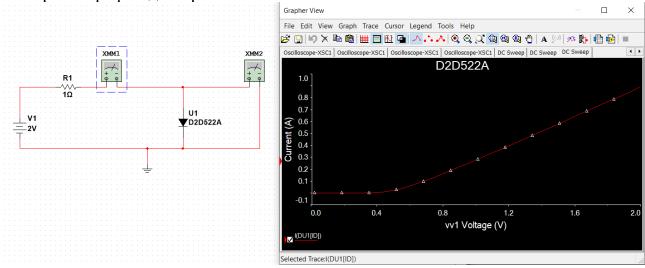


Произведем настройку для построения ВАХ

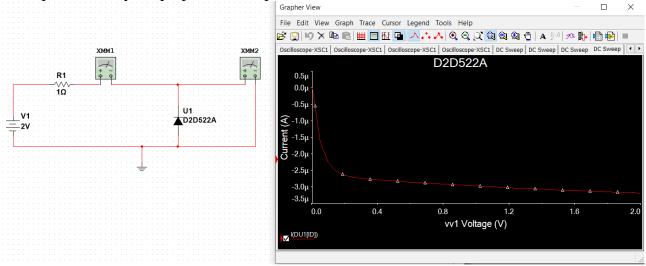




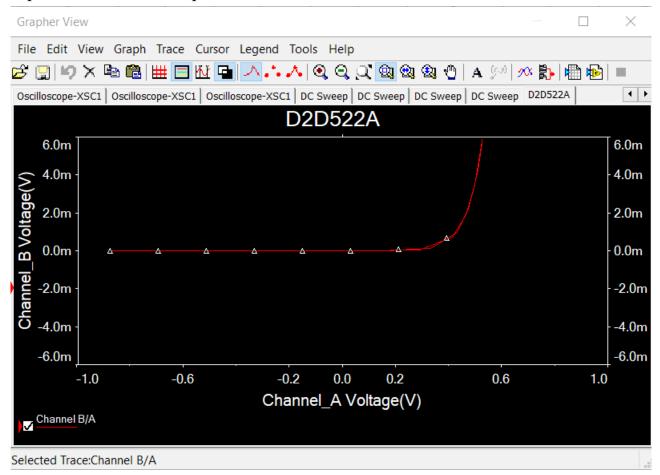
Построим график для прямого включения



Построим схему и график для обратного включения диода.

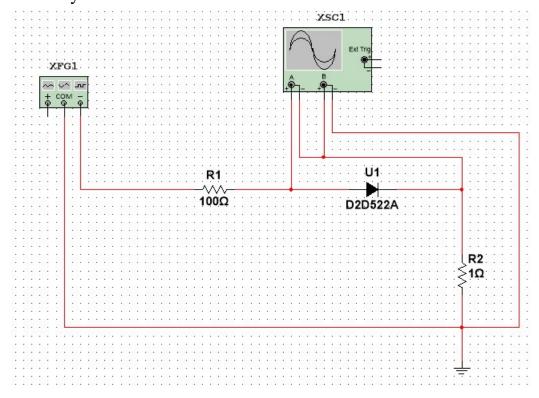


Передаем данные в GrapherView

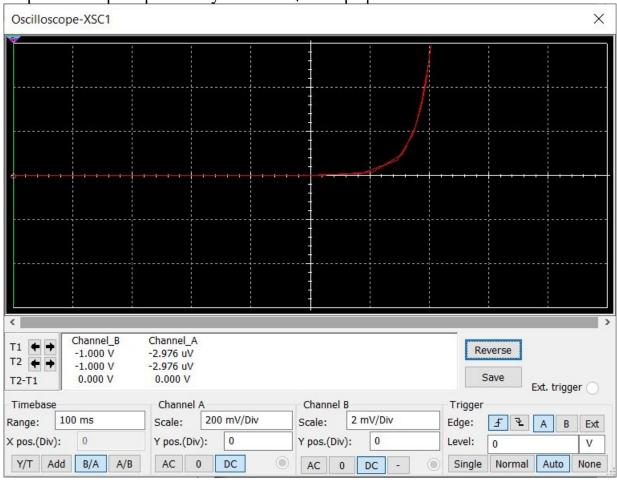


Эксперимент 3

Исследование ВАХ диода с помощью осциллографа и генератора. Собираем схему



Настраиваем приборы и запускаем осциллограф



Дальше точки переводим файл с расширение lvm и передаем его в Mathcad

VAX := READPRN("D:\study\OE\multisim\vax.1vm")

		0	1
VAX =	0	-0.02	8.658 · 10 - 7
	1	-0.019	9.036·10-7
	2	-0.017	9.413·10-7
	3	-0.016	9.791·10-7
	4	-0.014	1.017·10-6
	5	-0.012	1.055.10-6
	6	-0.011	1.092·10-6
	7	-9.318·10 ⁻³	1.13·10-6
	8	-7.729·10 ⁻³	1.168·10-6
	9	-6.14·10 ⁻³	1.206·10-6
	10	-4.55·10 ⁻³	1.244 · 10 - 6
	11	-2.961·10 ⁻³	1.281.10-6
	12	-1.372·10 ⁻³	1.319·10-6
	13	2.175 · 10 - 4	1.357·10-6
	14	1.807 · 10-3	1.395·10-6
	15	3.396·10-3	

Рассчитаем параметры диода через Given Minerr и сравним экспериментальную BAX с теоретической

$$Id3 := \max(VAX^{\langle 1 \rangle}) \qquad Ud3 := \max(VAX^{\langle 0 \rangle}) \qquad Id4 := \frac{Id3}{8} \qquad Ud4 := linterp\left(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, \frac{Id3}{6}\right)$$

$$Id1 := \frac{Id3}{4} \qquad Ud1 := linterp\left(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, \frac{Id3}{4}\right)$$

$$Id1 := \frac{Id3}{4} \qquad Ud1 := 0.328$$

$$Id2 := \frac{Id3}{5} \qquad Ud2 := linterp\left(VAX^{\langle 1 \rangle}, VAX^{\langle 0 \rangle}, \frac{Id3}{2}\right)$$

$$Id2 = 1.171 \times 10^{-3} \qquad Ud2 = 0.368$$

Given
$$Ud4 = Rb \cdot Id4 + ln \left[\frac{(Iso + Id4)}{Iso} \right] \cdot m \cdot Ft$$

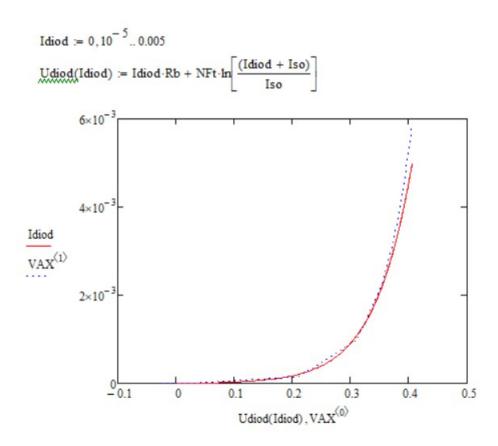
$$Ud1 = Id1 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Iso + Id1)}{Iso} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud2 = Id2 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Iso + Id2)}{Iso} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud3 = Id3 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Iso + Id3)}{Iso} \right] \cdot m \cdot Ft$$

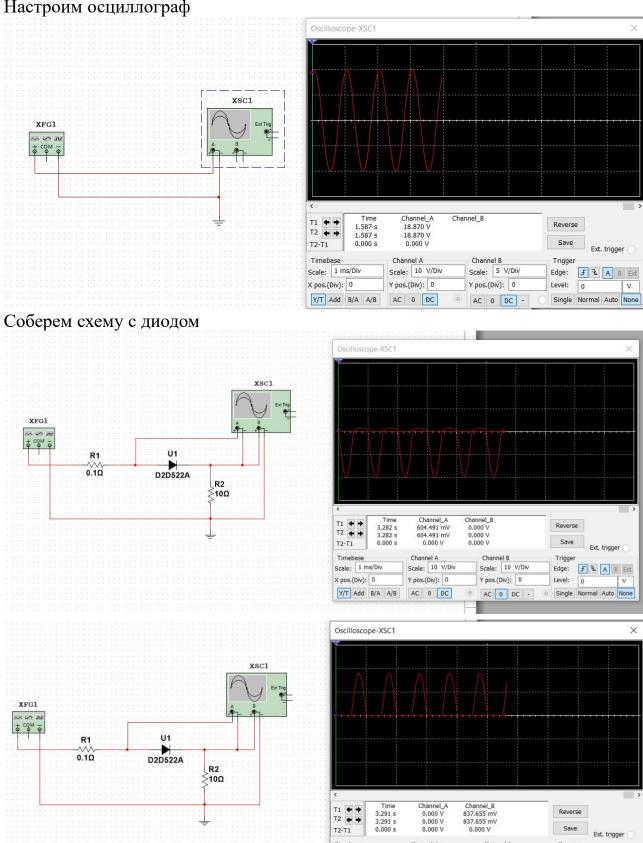
$$Diod_P := Minerr(Iso_Rb_m, Ft)$$

$$Diod_P = \begin{pmatrix} 6.732 \times 10^{-7} \\ -1.622 \\ 2.153 \\ 0.021 \end{pmatrix}$$



Эксперимент 4

Настроим осциллограф



Scale: 1 ms/Div

Y/T Add B/A A/B

X pos.(Div): 0

Scale: 10 V/Div

Y pos.(Div): 0

AC 0 DC

Scale: 10 V/Div

AC 0 DC -

Y pos.(Div): 0

Edge: F & A B Ext

Single Normal Auto None

Level: 0 Подключим параллельно резистору конденсатор

